(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 28. Dezember 2000 (28.12.2000)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 00/78674 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: C01B 31/06. 31/02, C09K 3/14, 5/14, H01B 3/02

199 55 971.6

19. November 1999 (19.11.1999) DE

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/01885

(71) Anmelder und

(72) Erfinder: SCHÖNEFELD, Christa [DE/DE]; Heinrich-Zille-Weg 2, D-52511 Geilenkirchen (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:

14. Juni 2000 (14.06.2000)

(72) Erfinder; und

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHÖNEFELD, Tejas

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

[DE/DE]; Ringstrasse 22, D-41849 Wassenberg (DE). (74) Anwälte: CASTEL, Klaus usw.; Patentanwaltskanzlei

(30) Angaben zur Priorität:

199 27 893.8

18. Juni 1999 (18.06.1999) DE Liermann-Castel, Gutenbergstrasse 12, D-52349 Düren (DE).

199 27 894.6

18. Juni 1999 (18.06.1999) DE

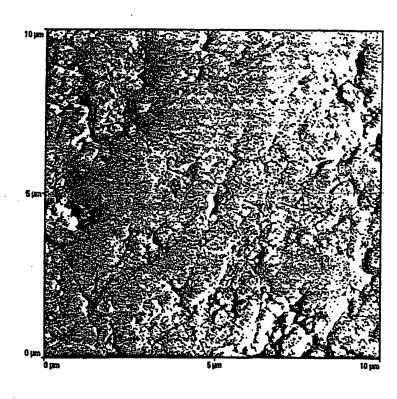
(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AL, AM, AT, AU,

199 27 895.4 18. Juni 1999 (18.06.1999) AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR THE CHEMODYNAMIC PRODUCTION OF DIAMOND-TYPE CARBON STRUCTURES, DIA-MOND-TYPE CARBON STRUCTURES AND USES OF DIAMOND-TYPE CARBON STRUCTURES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR DYNAMISCH-CHEMISCHEN HERSTELLUNG VON DIAMANTARTIGEN KOHLEN-STOFFSTRUKTUREN, DIAMANTARTIGE KOHLENSTOFFSTRUKTUREN UND VERWENDUNGEN VON DIAMANTAR-TIGEN KOHLENSTOFFSTRUKTUREN



(57) Abstract: In order to produce diamond-type carbon structures chemodynamically, a hybrid carbon phase is placed into a closed container and caused to chemically react with an energy vector, in order to obtain dispersed, condensed carbon the reaction product. Said reaction product is exposed to an atomically hydrogen-supported low-temperature plasma so that a phase conversion of carbon into highly pure, cuboid lattice structures is obtained. Diamond-type carbon structures can thus be achieved which have approximately 100 % purity of the cuboid diamond phase. The crystallite sizes lie between 5 nm and 50 nm and the cluster size range lies between 50 nm and 20 µm. The particle diameters in the dispersion are between 40 nm and 500 nm. The inventive carbon structures are suitable for treating the surfaces of hard substances, or for use as electric insulators or as heat transfer media. For these applications, the diamond-type carbon structures are added to a suspension, a dispersion, an emulsion, a spray, a paste, a grease, a

wax or a lacquer system.



DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der f\(\tilde{u}\)r \(\tilde{A}\)nderungen der Anspr\(\tilde{u}\)che geltenden
 Frist; Ver\(\tilde{o}\)flentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{A}\)nderungen
 eintreffen.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

⁽⁵⁷⁾ Zusammenfassung: Zur dynamisch-chemischen Herstellung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen wird in einen geschlossenen Behälter eine hybride Kohlenstoffphase gegeben, die mit einem Energieträger zur chemischen Reaktion gebracht wird, um dispersen kondensierten Kohlenstoff als Reaktionsprodukt zu erzielen. Dieses Reaktionsprodukt wird einem atomar wasserstoffgestützten Niedertemperatur-Plasma ausgesetzt, so daß eine Phasenumwandlung von Kohlenstoff in hochreine kubische Gitterstrukturen erzielt wird. Dadurch sind diamantartige Kohlenstoffstrukturen zu erhalten, die eine Reinheit der kubischen Diamantphase von etwa 100 % aufweisen. Die Kristallitgrößen liegen im Bereich zwischen 5 nm und 50 nm und die Cluster-Größenordnungen zwischen 50 nm und 20 μm. Die Partikeldurchmesser in Dispersion betragen zwischen 40 nm und 500 nm. Die erfindungsgemäßen Kohlenstoffstrukturen eignen sich zur Oberflächenbearbeitung von harten Werkstoffen, als elektrischer Isolator oder als Wärmeübertragungsmittel. Hierzu werden die diamantartigen Kohlenstoffstrukturen einer Suspension, einer Dispersion, einer Emulsion, einem Spray, einer Paste, einem Fett, einem Wachs oder einem Lacksystem zugegeben.

10

15

Verfahren zur dynamisch-chemischen Herstellung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, diamantartige Kohlenstoffstrukturen und Verwendungen von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen

Die Erfindung betrifft Verfahren zur dynamisch-chemischen Herstellung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, bei denen in einen geschlossenen Behälter eine hybride Kohlenstoffphase gegeben wird und mit einem Energieträger zur chemischen Reaktion gebracht wird, um dispersen kondensierten Kohlenstoff als Reaktionsprodukt zu bilden. Die Erfindung betrifft weiterhin verschiedene diamantartige Kohlenstoffstrukturen und Verwendungen derartiger Kohlenstoffstrukturen.

Disperser kondensierter Kohlenstoff wird als phasengewandelte Kohlenstoffstruktur, insbesondere im Rahmen der synthetischen Diamantherstellung, erzeugt. Neben statisch katalytischen Hochtemperatur-Druck-, Stoßdruck-, physikalischen (PVD) und chemischen (CVD) sowie kombinierten Verfahren finden auch sogenannte dynamische Verfahren Anwendung, die auf der chemischen Umsetzung energiereicher Stoffe und Verbindungen beruhen und zur Bildung von hexagonalen und kubischen Carbonstrukturen überwiegend in Form disperser und ultradisperser Systeme führen.

Die Grundlage der dynamisch chemischen Herstellung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen bilden die Gesetzmäßigkeiten, die sich bei der chemischen Umsetzung von hochenergetischen Stoffen, vorwiegend mit

10

15

20

negativer Sauerstoffbilanz, kurzzeitig vollziehen. Sie bestehen im wesentlichen darin, dass der bei der chemischen Reaktion dieser Stoffe freigesetzte und durch die Generatorgas-Reaktion charakterisierte kondensierte Kohlenstoff solchen Bedingungen ausgesetzt wird, dass eine Phasenumwandlung in höher strukturierte Kristallgitter-Strukturen von statten gehen kann.

Die chemische Reaktion kohlenstoffhaltiger Energieträger wird in der Regel durch Explosivstoffe mit negativer Sauerstoffbilanz erreicht und in geschlossenen Hochdruckbehältern unter Bedingungen einer inerten Gasatmosphäre durchgeführt. Der atmosphärische Sauerstoff ist dabei weitestgehend mittels Vakuumierung des Behältersystems zu eliminieren, um eine inerte Gasatmosphäre durch spezielle inerte Gase oder deren Gemische, die jeweils unter funktionalem Druck stehen, zu erzielen. Diese inerte Gasatmosphäre soll einer Regraphitierung der höher strukturierten Kohlenstoff-Phasen entgegenwirken.

Diese Verfahren sind jedoch technisch und technologisch äußerst aufwendig und unökonomisch. Trotz Bereitstellung von ultradispergierten kondensierten Kohlenstoff-Phasen in den Reaktionsprozess werden nur wirtschaftlich äußerst geringe Bildungsraten von etwa 8,0% bis 10,0% Massenanteil der jeweils hergestellten und erwünschten Kohlenstoffstrukturen, bezogen auf die Masse des eingesetzten Reaktions- bzw. Spendermaterials erreicht. Technologien dieser Art sind damit großtechnologisch und ökonomisch unrelevant.

10

15

Die mit diesem Verfahren hergestellten höher strukturierten Kohlenstoff-Systeme enthalten bis zu 40% hexagonale Diamantstrukturen (minderwertiger Lonstelit) sowie bis zu 30% röntgenamorphe Phasen und restlich kubische Diamantanteile, die jedoch Phasenreinheiten von nicht mehr als 85% bis 95% aufweisen. Damit liegen mechanische Gemenge von unterschiedlichen Carbonstrukturen mit praktisch nicht definierbaren Systemeigenschaften vor, deren technisch-industrielle Verwendbarkeit in starkem Maße eingeschränkt ist.

Darüber hinaus enthalten diese Stoffkonfigurationen auf der Materialoberfläche eine Vielzahl an funktionalen Gruppen sowie Kohlenstoffatome
mit freien Bindungen, die zu schwer definierbaren Oberflächenpolaritäten
führen und damit erforderliche Vernetzungsprozesse im Verbund mit
anderen Stoffen und Materialien erschweren oder sogar unmöglich machen.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur dynamisch chemischen Herstellung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen zu entwickeln, das eine wirtschaftliche Herstellungsweise bei gleichzeitig hoher Phasenreinheit ermöglicht. Darüber hinaus sollen diamantartige Kohlenstoffstrukturen mit definierten Eigenschaften bereitgestellt werden und neue Verwendungen derartiger Stoffe vorgeschlagen werden.

Verfahrensmäßig wird die Aufgabe mit einem gattungsgemäßen Verfahren gelöst, bei dem das Reaktionsprodukt einem atomar wasserstoffgestützten Niedertemperatur-Plasma ausgesetzt wird und eine Phasenumwandlung von

10

15

20

Kohlenstoffkombinationen in hochreine kubische Gitterstrukturen erzielt wird.

Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass die Verwendung eines atomar wasserstoffgestützten Niedertemperatur-Plasmas zu einer sehr hohen Prozessausbeute an hochreinen kubischen Gitterstrukturen führt.

Vorzugsweise wird zusätzlich ein Kohlenstoffspendersystem eingebracht. Dieses Kohlenstoffspendersystem weist vorzugsweise flüssige oder gasförmige Kohlenwasserstoffverbindungen auf, wobei vor allem mit organischen Kohlenwasserstoffverbindungen besonders gute Prozessergebnisse erzielt wurden.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass hybride Kohlenstoffsysteme, vorangig flüssige Kohlenwasserstoffverbindungen im Verbund mit
kondensiertem bei der chemischen Umsetzung der Energieträger entstehendem Kohlenstoff in einen hoch energetischen und kurzzeitlichen chemischen
und thermogasdynamischen Prozess derart eingeführt werden können, dass
einerseits die Herausbildung von kondensiertem Kohlenstoff stoichometrisch
unterstützt wird und andererseits die Kovaleszens bereits formierter bzw.
depositionierter Cluster aus der chemischen Reaktion eines eingesetzten
Energieträgers initiiert und optimal im komplexen System vollzogen werden
kann.

Der chemisch physikalische Bildungsprozess wird dabei unter Bedingungen eines atomar wasserstoffgestützten Niedertemperatur-Plasmas bei Anwesen-

heit von ${}^{n}H \ge 9,12x10^{17}$ dahingehend unterstützt, dass die Elektronenpromovierung mit nachgesetzter Hybridisierung vorwiegend nicht nach Diffusions- sondern nach Martensid-Mechanismus erfolgt.

Dadurch wird es ermöglicht diamantartige Kohlenstoffstrukturen großtechnologisch in nano- und mikroskaligen Kristallidbereichen sowie in cluster- und polykristallinen Strukturen mit neuen Herausstellungseigenschaften ökonomisch zu produzieren. Die derart hergestellten diamantartigen Kohlenstoffstrukturen können technisch so formiert werden, dass sie Ausgangsmaterialien für die Darstellung höher strukturierter Kohlenstoffsysteme, wie Fullerene, Hyper-Fullerene, Nano-Tubes, Onion-Like Carbons (OLC) u.a. bilden.

Gegenstand der Erfindung sind weiterhin diamantartige Kohlenstoffstrukturen, die sich dadurch auszeichnen, dass die Reinheit der kubischen Diamantphase bei 99%, vorzugsweise bei 100% liegt (NJC Scan 1/X-Ray-Pattern). Die Kristallitgrößen der Kohlenstoffstrukturen liegen im Bereich zwischen 5 nm und 50 nm (X-ray diffraction). Clustergrößenordnungen von 50 nm bis 20 µm (scanning electron microskope) wurden erreicht sowie Partikeldurchmesser in Dispersion von 40 nm bis 500 nm (photon correlation spectroscopy). Röntgenamorphe Phasen treten nicht auf.

Durch die Verfahrensführung können verschiedene Parameter des Materials variiert oder dotiert (cloning) werden: spezifische Oberflächenwerte, spezifische Magnetisierbarkeit, Zeta-Potential, spezifischer elektrischer

10

15

20

Widerstand, freie Energie in Bezug auf Wasserdampfaufnahme u.a. Auf diese Weise sind vor allem folgende Merkmale steuerbar: Porositäten und Sorbtionseigenschaften, Charakteristika, die definitive Vernetzungsparameter ergeben, Oberflächenpolaritäten in hydrophiler bzw. hydrophober Auslegung, Transfer-, elektrische Isolations- sowie Halbleitereigenschaften u.a.

Für das Super- und End-Finishing sowie für das Polishing, insbesondere das Nano-Polishing, das Planarisieren und das Trowalieren von harten und Werkstoffoberflächen gegenwärtig synthetische werden superharten hochharte Werkstoffe (Diamant kubisches Bornitrit, Metalloxide u.a.) verwendet, die aufgrund ihrer spezifischen Charakteristika, insbesondere der Blocking-isometrischen Formgebung und der damit in enger Beziehung stehenden Neigung zur Spaltflächenbildung bei entsprechenden mechanischen Belastungen gute abrasive Leistungen gewährleisten. Bei der Erzielung gegenwärtig in zunehmendem Maße geforderter hoher Oberflächengüten, vorwiegend in Nano-Bereichen stoßen diese Materialien jedoch an die Grenzen der technischen Machbarkeit. Polykristalline Diamantstrukturen der MYPOLEX der Firma DuPont (Erzeugung durch externe Art Explosionssynthese) haben gegenüber natürlichen und konventionell synthetisierten Industriediamanten folgende Vorteile:

ungeordnete Morphologie ohne bedeutende Spaltflächen ("selbstschärfende Teilchen") mit lateralen Mikroriss oder Spallationsmechanismen,

10

15

20

- gleichbleibende Härtecharakteristika und
- zwei bis dreimal größere spezifische Oberflächen.

Sie können jedoch den Bereich von $0,005~\mu Ra$ sowie Polspitzenrezessionen (PTR) von $0,01~\mu$ nicht unterschreiten. Darüber hinaus ist der industrielle Einsatz von Mypolexkonfigurationen und anderen Diamanthochleistungssystemen äußerst kostenintensiv und bei einer Reihe technischer Anwendungen nicht optimal und zielführend.

Die beschriebenen erfindungsgemäßen diamantartigen Kohlenstoffstrukturen können jedoch durch dynamisch-chemische Hybridtechnologien ökonomisch effizient produziert werden und weisen eine Vielzahl spezifischer Eigenschaften auf, die sie gegenüber konventionellen Industriediamantkonfigurationen herausstellen.

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften, insbesondere von Morphologie und Kornform sowie der spezifischen Oberflächencharakteristika und des mittleren Zeta-Potentials der erfindungsgemäßen diamantartigen Kohlenstoffstrukturen können an superharten Werkstoffoberflächen Finishwerte von Ra=2 nm bis 10 nm sowie Polspitzenrezessionen von PTR=0.5 nm bis 2 nm erreicht werden. Außerdem sind polishing Geschwindigkeiten von etwa 0,3 µm bis 5,0 µm pro Minute erzielbar, die optimale, schonende Glättungseffekte zur Folge haben.

10

15

Die Figuren 1 bis 4 zeigen die Ergebnisse der erfindungsgemäßen Nano-Politur einer vorgeschliffenen Oberfläche aus Siliziumnitritkeramik im Vergleich zu einer Hochleistungsdiamantkörnung. Die Figuren 1 und 2 zeigen eine Siliziumnitritkeramik, die geschliffen wurde und anschließend mit einer handelsüblichen Diamantsuspension poliert wurde. Die Figuren 3 und 4 zeigen im Gegensatz hierzu eine Nano-High-Endpolitur mit einer wässrig-kationisch, kurzkettigen Suspension aus diamantartigen Kohlenstoffstrukturen an einer geschliffenen Siliziumnitritkeramik.

Maßgebend für die vorteilhafte Verwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen zur Oberflächenbearbeitung von harten Werkstoffoberflächen sind anderem die linsenförmige (ogivale) Korngestaltung unter der Einzelkristalline sowie Syntheseprozess, der einen Kristallbildungsprozess von "unten" gewährleistet. Das heißt, das Korn bzw. die entsprechenden Clusterkonfigurationen wachsen auf eine definierte Größe auf und werden nicht, wie derzeit üblich, mittels Mahlvorgängen aus größeren Korngebilden gebrochen, was unweigerlich zu schärferen Konturen und zur Herausbildung von kohärenten Spaltebenen bei gleichzeitig verminderter Druckfestigkeit führt.

Die erfindungemäßen diamantartigen Kohlenstoffstrukturen eignen sich vor 20 allem für die folgenden Behandlungsverfahren:

Behandlung hochfester Keramiken, von Edelsteinen und Sonderwerkstoffen für Elemente und Baugruppen der Mikro- und

Hochleistungselektronik. Die optimale polishing-speed liegt hierbei zwischen 0,3 µm und 5 µm pro Minute.

- Präzisionspolituren an metallbeschichteten Teilen einer Memory-Disc oder von Metallspiegeln,
- 5 Behandlung von Teilen und Baugruppen aus Polykarbonaten wie Brillengläsern u.a.
 - Behandlung von optischen, optronischen und Laserbaugruppen sowie Magnetkopfsystemen,
 - Behandlung von orthopädischen und Dentalprothesen
- für Mikro-Honwerkzeuge, Miniatur- und Präzisionskugellager,
 für mechanische Dichtungs- und Gleitsysteme (wie unter anderem Pumpen, Ventile, Zylinder, Kolben, Lager, Buchsen sowie Oberflächen von Umformstempeln)
 - metallurgraphische und kristallographische Präparationen,
- Behandlung von Elementen und Baugruppen aus Polyacryl (zum Beispiel Fenster für Flugzeugkabinen u.a.) sowie von Kontaktlinsen,
 - Polituren komplizierter und nichtplanarer Oberflächen mittels
 Gleitschleifen (Trowalisieren) sowie Planarisieren von
 Elementen der Hochleistungs- und Mikroelektronik.

10

15

20

Zum Erreichen der angestrebten Kenn- und Leistungscharakteristika sind die erfindungsgemäßen diamantartigen Kohlenstoffstrukturen in speziell dafür ausgelegte Trägermedien einzugeben. Als Trägermedien eignen sich wässrige und organische wasserlösliche Suspensionen, Emulsionen, Trays, Fette, Pasten und Wachse.

Eine weitere vorteilhafte Verwendung von diamantartigen Kohlenstoff, insbesondere der oben beschriebenen Kohlenstoffstrukturen liegt im Einsatz Außerdem können die als elektrischer Isolator. diamantartigen Kohlenstoffstrukturen als Wärmeübertragungsmittel verwendet werden. Besonders vorteilhaft ist es, wenn neben der hohen Fähigkeiten zur elektrischen Isolation die Eigenschaften zum optimalen Transfer von Wärmeenergie von einem Körper auf den anderen genutzt werden können. Dies ist eine typische Aufgabestellung bei verlustbehafteten elektronischen Bauteilen. Erfindung beschreibt daher eine vorteilhafte Anwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, vorwiegend in Nano- und Mikrokörnungsbereichen als elektrische Isolier- oder thermische Transfermittel. Dies wird durch das Einbringen der Kohlenstoffe in Pasten, Kleber, Lacke, Fette, Lote und in kompositäre Werkstoffverbunde vorrangig für den technisch-industriellen Einsatz in Bereichen der Hochleistungselektronik, Mikroelektronik sowie Elektrotechnik und Energetik erreicht.

Bei elektronischen Bauteilen, insbesondere bei Halbleiterbauelementen besteht eine große Temperaturabhängigkeit bezüglich Linearität und Funktionsfähigkeit. Geht man davon aus, daß zum Beispiel Sperrschicht-

10

kristalle aus Germanium in Temperaturbereichen zwischen 85 °C und 100 °C belastbar sind und die Linearität der Bauelemente oft nur in einem begrenzten Bereich schaltungstechnisch ausreichend ist, muss produzierte Wärme nach Außen abgeleitet werden, um die Betriebsbereitschaft zu gewährleisten und den Halbleiter in einem festgelegten Temperaturfenster zu halten.

Gegenwärtig wird mit Hilfe von Kühlkörpern die aktive wärmeabgebende Oberfläche vergrößert. Da jedoch diese Hochleistungsbauelemente nicht plan sind und deshalb eine gewisse Rauhigkeit aufweisen, werden sie mittels eines sogenannten wärmeleitenden Mediums mit dem Kühlkörper verbunden. Diese Medien müssen dabei gleichzeitig eine außerordentlich hohe elektrische Isolierfähigkeit aufweisen und eine optimale Anpassung an die entsprechende Oberfläche garantieren ohne andererseits ein Fließverhalten zu zeigen.

Bisher bekannte Pasten, Fette, Lacke, Kleber, Lote, Foliensysteme u.a. deren thermische Transfereigenschaften durch ihre spezifische und material-abhängige Leitfähigkeit beschrieben werden, können physikalisch bedingt Leitwerte von 2,5 W/mK bisher nicht überschreiten. Außerdem ist bei den bekannten Medienwerkstoffen wie Glimmer, Aluminiumoxid, Bornitrit oder Berylliumoxid nachteilig, daß sie zum Teil hoch toxisch sind (zum Beispiel Berylliumoxid) und einen hohen spezifischen thermischen Leitwiderstand aufweisen. Dies betrifft insbesondere keramische und polimerische Foliensysteme. Viskose Systeme wie Pasten, Fette, Lacke, Kleber u.a.

10

15

können meist nicht bereits während des Herstellungsprozesses der zu kühlenden elektronischen Komponente aufgebracht werden und sind daher schwer zu handhaben.

Die Verwendung diamantartiger Kohlenstoffstrukturen als elektrischer Isolator von Wärmeübertragungsmitteln führt zu erheblich verbesserten Kennund Leistungscharakteristika und gewährleistet eine optimale Verarbeitung mit dem entsprechenden Medienträger in Anpassung an die jeweilige Komponente. Gleichzeitig stellt dabei das erfindungsgemäße Material einen optimalen elektrischen Isolator dar und führt zur Verbesserung einer Reihe weiterer Leistungscharakteristika des Gesamtsystems wie Härte, Dielektrizitätskonstante, Durchschlagspannung, spezifische Dichte, Zug-, Bruch-, und Durchdrückfestigkeit, Dehnung, Verlustfaktor u.a.

Das erfindungsgemäße Material ist anwendungsspezifisch dotierbar und lässt sich großtechnologisch und kostengünstig herstellen. Die technische Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sowie die Leistungsfähigkeit gängiger Elektronikkomponenten lässt sich darüber hinaus durch optimierte Verlustleistungsabfuhr ohne konstruktive Änderungen der Baugruppen und Bauteile erheblich steigern.

Zum Erreichen der Kenn- und Leistungscharakteristika werden entsprechen20 den Trägersystemen diamantartige Kohlenstoffstrukturen in fester
hochdisperser Form oder als Suspension, Dispersion oder Emulsion beigegeben. Erfindungsgemäß weisen dabei die so beigegebenen Kohlenstoff-

strukturen hochstrukturierte Oberflächen sowie Formen auf, die insbesondere eine gezielte Variierung der erforderlichen Vernetzungs-, Suspendier- und Dispergiereigenschaften ermöglichen, um optimale Systemcharakteristika zu gewährleisten.

Im folgenden werden verschiedene Anwendungsbeispiele des erfindungsgemäßen Verfahrens und zur Verwendung der erfindungsgemäßen diamantartigen Kohlenstoffstrukturen dargestellt und näher beschrieben.

Zur dynamisch chemischen Herstellung diamantartiger Kohlenstoffstrukturen wird in das Zentrum eines geschlossenen Hochdruckreaktorsystems (autoklav) mit geometrischen Abmessungen im Verhältnis L/H mod 8,6 bis 10 9,2 (L=Länge, H=Höhe) sowie R/H mod 4 bis 6 (R=innerer Radius) im Volumen 3,0 m³ ein Energieträger wie beispielsweise 2, 4, 6 Tri-Nito-Toluol/Zyklotrimethylentrinitramin (50/50) der Masse 0,5 zylindrischer Form eingebracht. Die chemische des Energieträgers hat dabei unter Bedingungen eines leichten Vakuums (ca. 2 15 mm Hg) zu erfolgen, das durch eine entsprechende Vakuumpumpe erzeugt wird. Hierbei sind folgende Prozessparameter einzuhalten:

- Druckplateau im chemischen Peak: P= 20 bis 30 Gpa
- Temperaturplateau im chemischen Peak: $T \ge 4.000 \text{ K}$
- 20 Länge des P/T-Plateaus: $T \le 3 \times 10^{-6} \text{ s}$
 - Umsetzungsgeschwindigkeit: $D \ge 8,32 \times 10^3 \text{ m/s}$.

Die Initiierung der chemischen Reaktion erfolgt mittels eines elektrisch erzeugten thermischen und dynamischen Impulses (Elektrodetonator).

Beispiel 1

15

- 5 Unter Einhaltung der oben genannten technologischen Rahmenbedingungen wird bei 4.000 K ein atomarwasserstoffgestütztes Niedertemperaturplasma erzeugt:
 - Teilchenanzahl in cm³: " $H \ge 9.4 \times 10^{17}$; " $O \ge 4.7 \times 10^{17}$
 - Dichte $[g/cm^3]$: 2,3 x 10⁻⁵
- 10 Enthalpie [J/kg]: 3.4×10^4
 - spezifische Wärme [J/gK]: 32,5.

Für die unterstützende chemische Formierung kubischer Kohlestoff-Strukturen wird über eine, das Energieträgersystem umgebende Wasservorlage unter Einwirkung der oben angegebenen Prozessparameter (Druck, Temperatur, Zeit) ein Wasserdampfplasma erzeugt. Die Dicke der Wasservorlage entspricht hierbei dreimal dem Durchmesser des zylindrischen Körpers des eingesetzten Energieträgers.

Die im Ergebnis dieses Prozesses formierten diamantartigen Kohlenstoffstrukturen zeichnen sich durch folgende Parameter und Charakteristika aus:

- Prozess-Output (Prozessausbeute) an erfindungsgemäßen diamantartigen Kohlenstoffstrukturen 10,43 % (bezogen auf die eingesetzte Masse des Energieträgers)
- Reinheit der kubischen Kristallgitter-Phase: 2 θ = 100 %, kein Nachweis röntgenamorpher Phasenanteile (vgl. Fig. 5)
- spezifische Oberfläche: 267,85 m²/g
- Zeta-Potential: + 10 mV
- Oberflächenpolarität: hydrophob
- weitere Parameter entsprechend den Figuren 1 und 2.

15

5

Beispiel 2

Unter Beibehaltung der generellen technologischen Rahmenbedingungen sowie der Bedingungen zur Erzeugung eines atomarwasserstoffgestützten Niedertemperatur-Wasserdampf-Plasmas gemäß Beispiel 1 sind vor der Initiierung der chemischen Umsetzungsreaktion gas-/flüssige Trägergemische wie beispielsweise Äthylen/Butan/Propan im Volumenverhältnis 20/40/40 mit einem Druckniveau im Bereich von 0,3 Mpa bis 0,8 Mpa in das Hochdruckreaktorsystem einzubringen oder einzublasen.

Dadurch ändern sich die Kenn- und Leistungscharakteristika der erzeugten diamantartigen Kohlenstoffstrukturen wie folgt:

- Prozess-Output an erfindungsgemäßen Kohlenstoffstrukturen: 12,42 %
- Reinheit der kubischen Kristallgitter-Phase: 100 %
- spezifische Oberfläche: 298,85 m²/g
- 5 Zeta-Potential: +5,6 mV
 - Oberflächenpolarität: schwach hydrophob

Beispiel 3

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel werden unter Beibehaltung der oben beschriebenen Bedingungen zur Erzeugung eines atomarwasserstoffgestützten Niedertemperatur-Wasserdampf-Plasmas vor der Initiierung der chemischen Umsetzungsreaktion flüssige organische Kohlenstoffspendersysteme der aliphatischen Reihe, wie Grenzkohlenwasserstoffe oder ein- oder mehrwertige Alkohole (zum Beispiel Ethylenglycol) in Form einer Ummantelung zwischen zylindrischem Körper des Energieträgers und Wasservorlage in das System eingebracht.

Die Masse (M_{KS}) des Kohlenstoffspendersystems ist dabei wie folgt zu ermitteln:

$$M_{KS} = A \times M/100-A, [g]$$

A = %-Anteil des Kohlenstoffspendersystems im Gesamtreaktionssystem und M = Masse Energieträger + Masse Kohlenstoffspender, wobei A (%) in Bereichen von 13,8 bis 15,1 liegen muss.

Dieser Verfahrensschritt liefert erfindungsgemäße diamantartige Kohlenstoff-5 strukturen mit überwiegend nachstehenden Eigenschaften:

- Prozess-Output: 31,6 %
- Reinheit der kubischen Kristallgitter-Phase: 100 %
- spezifische Oberfläche: 325,65 m²/g
- Zeta-Potential: 4,5 mV
- 10 Oberflächenpolarität: schwach hydrophil.

Beispiel 4

15

Bei diesem Ausführungsbeispiel werden sämtliche Parameter des Beispiels 3 beibehalten und als Kohlenstoffspendersysteme ungesättigte Alkohole (wie beispielsweise Propargylalkohol oder Allylalkohol) bzw. aromatische Verbindungen (wie beispielsweise Benzol, Nitrobenzol oder Acetonitril) eingesetzt. Der dabei einzusetzende Wert von A (%) muss im Bereich zwischen 12,8 und 17,3 liegen.

Die dadurch zu erzeugenden diamantartigen Kohlenstoffstrukturen weisen folgende Charakteristika auf:

- Prozess-Output: 52,4 %
- Reinheit der kubischen Kristallgitter-Phase: 100 %
- 5 Zeta-Potential: + 10,0 mV
 - spezifische Oberfläche: 348,50 m²/g
 - Oberflächenpolarität: stark hydrophil.

Beispiel 5

10 Unter Beibehaltung der generellen technisch-technologischen Parameter wird in der Hochdruckreaktoreinheit in Form einer Ummantelung des zylindrischen Energieträgersystems ein wässriger Slurry aus DLSC-Material (zum Beispiel mit den Technologiestufen der Beispiele 1 bis 4 hergestellt) und 5 bis 8 % Wasser (entionisiert) etabliert. Die Masse des Slurry-Systems hat mindestens dem 1,35-fachen der Masse des Energieträgers zu entsprechen. Die hierdurch entstehenden diamantartigen Kohlenstoffstrukturen stellen sich in polykristalliner Form (PK-DLSC) mit typisch gespreizten X-ray-Pattern-Peaks bei (111), (220) und (311) dar. Das X-ray-Muster ist in Figur 6 gezeigt.

Die Kristallitgrößen liegen in Bereichen von 5 bis 20 nm und sind über sp³-Hybridisierung entsprechend polykristallisiert. Die somit vorliegenden Polykristalle mit einer 100 %-igen Reinheit der kubischen Kristallgitter-Phase bewegen sich in Korngrößenbereichen von etwa 0,5 µm bis 15 µm, wobei ein Medianwert von 3,43 µm sowie Standardabweichungen von weniger als 2,41 µm erreicht werden können. Die Figur 7 zeigt das Korngrößenverteilungsdiagramm. Der Prozess-Output dieses technologischen Verfahrens beträgt ca. 50 %.

Die folgenden Kenn- und Leistungscharakteristika werden von den diamantartigen Kohlenstoffstrukturen sämtlicher Beispiele 1 bis 5 erreicht:

Modifikationsfarbe	hellgrau bis schwarz
Phasenanteil Carbon cub.	98 - 100 % [(111)50/37 = 2 ⊖]
Kornform - monokristallin/Cluster	ogival
Körnungsbereich -	5 nm - 10 μm
monokristallin/Cluster	50 nm - 20 μm
Schüttdichte, mittlere	0,4 g/cm ³
Dichte, pykrometrische	3,42 g/cm ³
Oberfläche, spezifische	200-350 m ² /g

Magnetisierbarkeit, spez.	$> 4 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$
Zeta-Potential	- 15/+ 10 mV
Bestandteile, unverbrennbar	< 2 %
Anteile, flüchtige	< 3 %
Beimengungen	·
Wasserstoff	< 0,9 %
Stickstoff	< 2,0 %
Sauerstoff	< 10,0 %
Wärmekonduktivität	1.300-2.100 W/mK
Ausdehnungskoeffizient, linear	1,1-3,6 x 10 ⁻⁶ K
Oxidationstemperatur a.d. Luft	> 400 °C
Graphitisierungstemperatur in	1.100-1.250 °C
Vakuum	

Prototyp 1

hydrophilisierte spezifische Oberflächenparameter spezifische Magnetisierbarkeit: (- 0,4) Lambda x 10⁻⁸ m³/kg spezifischer elektrischer Widerstand: 1,6 x 10¹⁰ Ohm x m freie Energie (Wasserdampfaufnahme): - 973,2 mJ/g x Mol

Prototyp 2

5

10

hydrophobisierte spezifische Oberflächenparameter spezifische Magnetisierbarkeit: (0,36) Lambda x 10 ⁻⁸ m³/kg spezifischer elektrischer Widerstand: 6,6 x 10¹⁰ Ohm x m freie Energie (Wasserdampfaufnahme): - 2,22 mJ/g x Mol

Die beschriebenen sogenannten DLSC-Materialien in mono- sowie polykristalliner Darstellungsform stellen eine neue Generation von hochstrukturierten Kohlenstoffsystemen dar, deren generelle Kenn- und
15 Leistungscharakteristika der kubischen Kristallgitter-Phase des reinen
Diamant entsprechen und darüber hinaus eine Reihe spezifischer, chemischphysikalischer und vor allem dotiert variierbarer Eigenschaften aufweisen.
Das vorliegende Material gestattet es somit, aus morphologischer Sicht
relevante technische Schnittstellen für den Übergang zu hyperstrukturierten

Kohlenstoffsystemen, insbesondere zu Fulleren, Hyper-Fulleren in Form von Onion-Like-Carbons sowie Nano-Tubes zu realisieren.

Unter additiver Einbringung der oben genannten und vorliegend dargestellten Eigenschaften ist das Material sowohl in eigenständiger Form als auch im Verbund mit anderen Werkstoffen (Composites) vorteilhaft gegenüber bekannten Stoffen sowie konventionellen Substanzen, vor allem für die im folgenden aufgeführten Applikationsfelder einsetzbar:

- Abrasive und tribologische Systeme für Nano-High-Finishing von hochvergüteten Werkstoffoberflächen
- 10 Transfer- und Isolationssysteme
 - Ingenieur-Composite
 - Beschichtungssysteme
 - ausgewählte bio- und gentechnische Werkstoffe.

Für die Oberflächenbehandlung von harten und superharten Werkstoffen sind die DLSC in speziell dafür ausgelegte Trägermedien einzugeben. Dies wird anhand der folgenden Beispiele exemplarisch erläutert:

Beispiel 1

20

5

Wässrige Suspensionen von Sprays auf der Basis kationischer kurzkettiger Suspendierhilfsmittel (Dispergier- und Stabilisierungssysteme) mit Polyrisationsgraden von ca. 100 bis 5.000.

	(1) Suspension:DLSC - S/0,n,n Inhaltsstoffe:	
5	 DLSC, monokristallin, Korngrößenklassierung 0,n,n. Poly-Dimethydiallylammoniumchlorid Natriumpolyacrylat 	: 0,1- 25,0 %
	Chitosan • Destilliertes Wasser :	: 1,0 - 8,0 % : % - Restanteil
10	• PH -Wert	: 4 -12
15	(2) Suspension: DLSC - S I / 0,nn Inhaltsstoffe:	
	 DLSC, polykristallin, Korngrößenklassierung 0,nn Poly-Dimethyldiallylammoniumchlorid Destilliertes Wasser 	: 0,1 -10,0 % : 2,0 4,0 % : % - Restanteil
20	• PH-Wert	:4-12
	(3) Spray: DLSC - Sp / 0,nn Inhaltsstoffe: - wie (1) -	
25	Träger- / Treibmittel: Polyglykol, Propan, Butan	
30	(4) Spray: DLSC - SpI / 0,nn Inhaltsstoffe: -wie (2) -	
30	Träger- / Treibmittel: - wie (3) -	•
35	(5) Slurry: DLSC - PRM/0,nn Inhaltsstoffe:	,
	 Komposit Graphit-Kohlenstoff/DSC (70/30) Poly- Dimethyldiallylammoniumchlorid Postilliamas Wasser 	: 0,1 - 20 % : 1,0 - 8,0 %
40	Destilliertes Wasser PH-Wert	: % -Restanteil :4-12

5	 (6) Slurry: DLSC - SL/ 0,nlnl / 0,n2n2 Inhaltsstoffe: DLSC, monokristallin, Körungsklassen 0,nlnl Industriediamant, monokristallin, Körnungsklassen 0,n2n Destilliertes Wasser PH - Wert 	: 0,1-15 % : 0,05 - 2,0% : %-Restanteil : 4-12
10	Beispiel 2 DLSC – Emulsion auf der Basis wasserlöslicher organischer Ver	rbindungen
	(1) Emulsion: DLSC – E / 0,nn	
15	Inhaltsstoffe: • DLSC, monokristallin, Körnungsklassen 0,nn • Silikonöl AK 230	: 1,0 - 8,0 % : 6,0 %
	• Hoechstwachs S	: 5,0 %
	OleinTestbenzin	: 0,7 % : 20,0 %
20	Diethlylaminoethanol	: 1,3 %
	• Ethylenglykol	: 5,0 %
	Destilliertes Wasser	. % - Restanteil
25	(2) Emulsion: DLSC – EI / 0,nn Inhaltsstoffe:	
	• DLSC, polykristallin, Körnungsklassen 0,nn - wie (1)	: 0,5 - 6,0 %
30		
	Beispiel 3 DLSC - Pasten /wachse auf vier Basis wasserlöslicher organisch	ner Verbindungen
25	(1) Paste: DLSC - P / 0,nn	
35	Inhaltsstoffe: • DLSC, monokristallin, Körungsklassen 0,n,n	: 4,0 -12 %
	Hoechstwachs KSL	: 5,0 %
	• Stearinsäure, technisch	: 4,0 %
	• Petroleum	: 10,0 %
40	• Zitronensäure	: 5,0 %
	• Kaliumhydoxid (86 %)	: 6,0 %
	• Destilliertes Wasser	: % - Restanteil

(2) Paste: DLSC - P I /0,n,n

Inhaltssoffe:

• DLSC, polykristallin, Körnungsklassen 0,n...,n

: 1,0 - 10 %

5 • - wie (1)

Der Kundennutzen für verschiedene Anwendungsgebiete relativ zum besten Stand der Technik ist im folgenden dargestellt:

Wärmeleitsysteme als Folien, Kleber, Vergussmassen, Pasten, Lote, Tapes

Systemparameter	Added-Value-Factor [AVF]
Wärmeleitfähigkeit	> 7
Thermischer Widerstand	> 5
Dielektrizitätskonstante [60 Hz]	> 2
Dielektrizitätskonstante [1 kHz]	> 3
Temperaturbereich (Dauerbetrieb)	1,3
Spez. Volumen-/Durchgangswiderstand	> 2,3
Durchschlagsspannung	> 1,7
Härte Shore A	> 1,3
Spezifische Dichte	< 1,8

Zugfestigkeit	> 2,6
Bruchfestigkeit	1,3
Dehnung	< 2
Durchdrückfestigkeit	> 1,3
Verlustfaktor [60 Hz]	> 35
Verlustfaktor [1 kHz]	> 20

gravierende Erhöhung der Chemikalienstabilität sowie der Festigkeit gegenüber gasförmigen und flüssigen aggressiven Medien

5 Abrasive und Tribologische Systeme als Suspensionen, Emulsionen, Wachse, Sprays, Trockenmittel ...

Systemparameter	Added-Value-Factor [AVF]
Verringerung des Reibungskoeffizienten	> 1,9
Erzielung von Rauigkeitsgüten bis in den Molekularbereich	< 5 - 10 nm

Ingenieurkeramiken, Ingenieurpolymere, Tapes, Beschichtungen, Nano-Composites ...

Systemparameter	Added-Value-Factor [AVF]
Abriebfestigkeit	> 1,8
Friktionskoeffizient	> 1,8
Dehnungsspannung bei 300 % Längung	1,9
Dehnungsfestigkeit	> 1,45
Relative Längung	> 1,35
Rissbildungswiderstand	> 2,4
Erhöhung der funktionalen Standfestigkeit von Elementen, Baugruppen und Teilen	3 - 20

Oberflächenbeschichtungen als Pulver-, Galvanische-, oder Polymerbeschichtungen

Systemparameter	Added-Value-Factor [AVF]
Mikrohärte	> 2
Verschleiß	> 1,8
Reibungen gegen Stahl	> 12-30
Standfestigkeiten	> 4-15
Lebensdauerzyklen	> 4-15

Patentansprüche:

- Verfahren zur dynamisch-chemischen Herstellung von diamantartigen
 Kohlenstoffstrukturen,
 - bei dem in einen geschlossenen Behälter eine hybride Kohlenstoffphase gegeben wird und
 - mit einem Energieträger zur chemischen Reaktion gebracht wird, um dispersen kondensierten Kohlenstoff als Reaktionsprodukt zu bilden,
- dadurch gekennzeichnet, daß das Reaktionsprodukt einem atomar wasserstoffgestützten Niedertemperatur-Plasma ausgesetzt wird und eine Phasenumwandlung von Kohlenstoffkombinationen in hochreine kubische Gitterstrukturen erzielt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich
 ein Kohlenstoffspendersystem eingebracht wird.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Kohlenstoffspendersystem flüssige oder gasförmige Kohlenwasserstoffverbindungen aufweist.

- 4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Kohlenstoffspendersystem organische Kohlenstoffverbindungen aufweist.
- 5. Diamantartige Kohlenstoffstruktur, dadurch gekennzeichnet, daß die
 5 Reinheit der kubischen Diamantphase bei 99 % vorzugsweise bei 100 % liegt.
 - 6. Diamantartige Kohlenstoffstruktur, dadurch gekennzeichnet, daß die Kristallitgrößen im Bereich zwischen 5 nm und 50 nm liegen.
- 7. Diamantartige Kohlenstoffstruktur, dadurch gekennzeichnet, daß die
 10 Cluster-Größenordnungen zwischen 50 nm und 20 µm liegen.
 - 8. Diamantartige Kohlenstoffstruktur, dadurch gekennzeichnet, daß die Partikeldurchmesser in Dispersion zwischen 40 nm und 500 nm liegen.
- Verwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, insbesondere
 nach einem der vorhergehenden Ansprüche, zur Oberflächenbearbeitung von harten Werkstoffen.
 - 10. Verwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 8, als elektrischer Isolator.
- Verwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, insbesondere
 nach einem der Ansprüche 1 bis 8, als Wärmeübertragungsmittel.

12. Verwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 8, als Zusatz zu einer Suspension, Dispersion, Emulsion, einem Spray, einer Paste, einem Fett oder einem Wachs.

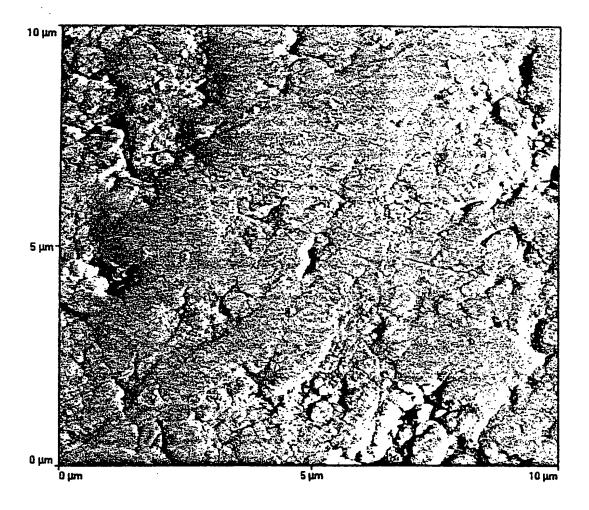


Fig. 1

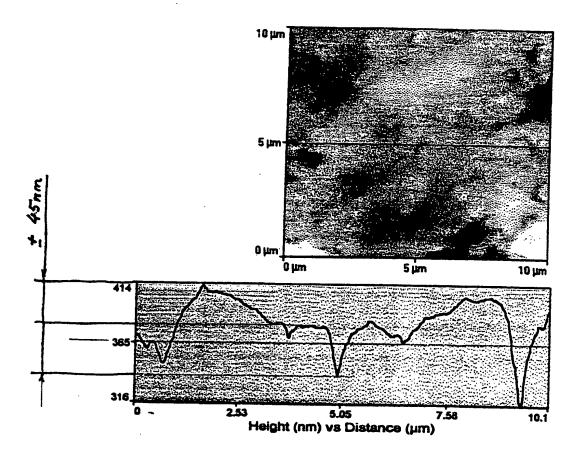


Fig. 2

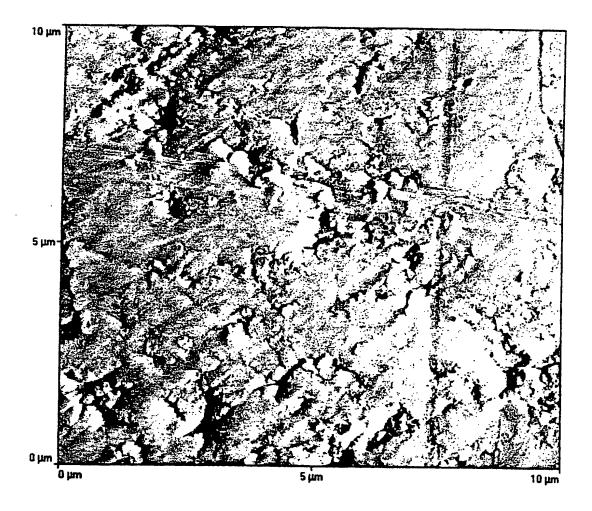
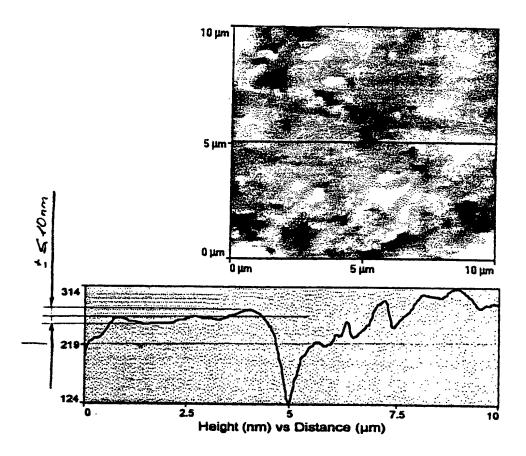


Fig. 3



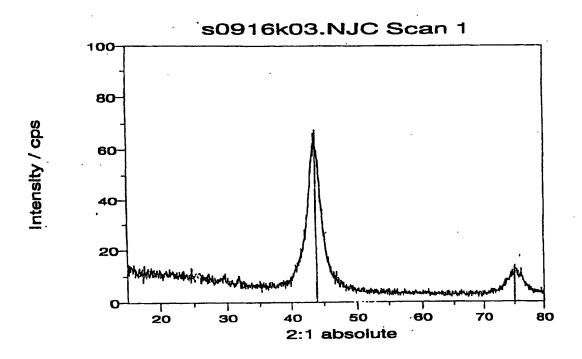


Fig. 5

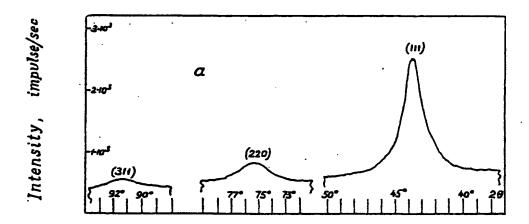


Fig. 6

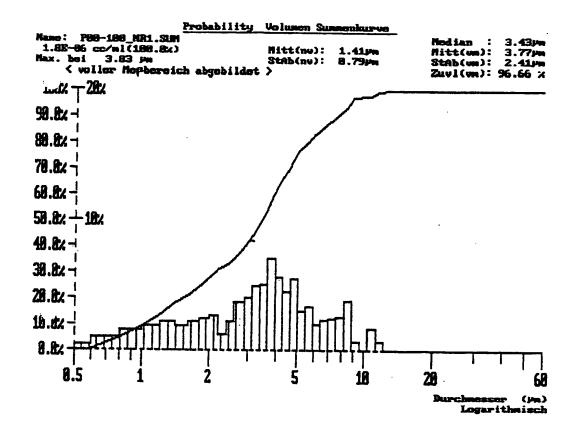


Fig. 7

<u>:</u> .

9.1

PCT

REC'D 2 5 SEP 2001

WIPO

VARBEIT

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	Maranna								
P01217WO	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)							
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmel								
PCT/DE 00/01885	(Tag/Monat/Jahr) 14/06/2000	18/06/1999							
Internationale Patentklassifikation (IPK) of									
, ,	C01B31/06								
Anmelder									
CARBO-TEC GESELLSCHAFT FÜR NANO-UND BIOTECHNISHE									
	OR REAL ORD BIG	715011(15)11(
Der internationale vorläufige Prüft Behörde erstellt und wird dem Ann	ungsbericht wurde von d nelder gemäß Artikel 36	er mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten übermittelt.							
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesa	arnt Blätter	einschließlich dieses Deckblatts.							
	egel 70.16 und Abschnit	handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenomt 607 der Verwaltungsvorschriften zum PCT)							
3. Dieser Bericht enthält Angaben und	d die entsprechenden Sei	en zu folgenden Punkten:							
I X Grundlage des Berichts									
II Priorität									
		erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit							
IV Mangelnde Einheitlichke	_								
V Begründete Feststellung gewerblichen Anwendba	nach Artikel 35(2) hinsi rkeit; Unterlagen und Er	chtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der klärungen zur Stützung dieser Feststellung							
VI Bestimmte angeführte U	Jnterlagen								
	nternationalen Anmeldur	ng							
	n zur internationalen An								
		-							
		₩							
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellung dieses Berichts							
18/12/2000		1 3. 09. 01							
Name und Postanschrift der mit der internati Prüfung beauftragten Behörde	ionalen vorläufigen	Bevollmächtigter Bediensteter							
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 523 Fax: (+49-89) 2399-4465	656 epmu d	The work of the first of the fi							
Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt)(Juli 199	98) (06/0	9/2001)							

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE00/01885

I. Grundlage des Berichts

;, 😶

1	Diese wurde entha	en, gel	cht wurde erstellt a ten im Rahmen di	auf der Grundlag ieses Berichts als	e (Ersatzblätter, die dem Anm s "ursprünglich eingereicht" un	eldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 l d sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änder	hin vorgelegt rungen
			der internationa	alen Anmeldung	In der ursprünglich eingereich	ten Fassung	
		X	der Beschreibu	ing, Seite	1 - 28	in der ursprünglich eingereichten Fa	ssung
				Seite		, eingereicht mit dem Antrag	
				Seite		, eingereicht mit Schreiben vom	
		X	der Ansprüche,	Nr.		in der ursprünglich eingereichten Fa	ssung
				Nr.		in der nach Artikel 19 geänderten Fa	ssung
				Nr.		, eingereicht mit dem Antrag	
				Nr.	1 - 12	, eingereicht mit Schreiben vom	06/07/2001
		X	der Zeichnunge	n, Blatt / Abb.	1/6 - 6/6	in der ursprünglich eingereichten Fas	ssung
				Blatt / Abb.		, eingereicht mit dem Antrag	
				Blatt / Abb.	•	, eingereicht mit Schreiben vom	
2.	Aufgrur	nd der	Änderungen sind	folgende Unterla	agen fortgefallen:		
			Beschreibung:	Seite			
			Ansprüche:	Nr.		\$. ⁷	
			Zeichnungen:	Blatt / Abb.		**	
3.		ange	er Bericht ist ohne gebenen Gründer Isgehen (Regel 70	n nach Auffassun	g (von einigen) der Änderungs g der Behörde über den Offen	en erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfo barungsgehalt in der ursprünglich eingereichte	eld n Fassung
4.	Etwaige	zusät	zliche Bemerkung	gen:			

4.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

PCT/DE00/018845

Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der ٧. gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

4. .

Neuheit	Ansprüche	1 - 12	JA
	Ansprüche		NEIN
Erfinderische Tätigkeit	Ansprüche	1 - 12	JA
	Ansprüche		NEIN
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ansprüche	1 - 12	JA
	Ansprüche		NEIN

2. Unterlagen und Erklärungen

B1 D1 = Applied Physics letter 67 (1995) July 31, N° 5, pp 694 - 696 Yoshikawa et Al.

D2 = XP 002 151 880

D3 = XP 002 151 881

D4 = DE 4 038 190

D5 = XP 002 151 876

D6 = XP 002 151 877

- Die Entgegenhaltungen D5 und D6 beschreiben Verfahren zur chemischen 1.a) Herstellung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, während die Patentanmeldung ein dvnamisch-chemisches Verfahren beschreibt, bei dem kurzzeitig hohe Drücke im Bereich von über 10 Gpa sowie Temperaturen über 2000° C entstehen. Dies hat zur Folge, daß bei den Verfahren gemäß den Entgegenhaltungen D5 und D6 ein polykristalliner Diamantfilm entsteht, während bei dem erfindungsgemäßen Verfahren im Wesentlichen ein nanometrisches Diamantpulver in monokristalliner Form entsteht.
 - b) Der mit einem verfahren gemäß den Entgegenhaltungen D5 und D6 erzeugte polykristalline Diamantfilm hat eine röntgenamorphe Struktur, das heißt die kubischen Gitterstrukturen sind nicht hochrein, sondern verzerrt. Die Herstellung nanometrischer hochreiner Diamantkristalle, vorzugsweise in Pulverform, ist mit einem Verfahren gemäß den Entgegenhaltungen D5 und D6 nicht möglich.



PCT/DE00/01885

- Die Entgegenhaltungen D5 und D6 beschreiben ein CVD-Verfahren, wie es in der c) Einleitung der Patentanmeldung auf Seite 1, Zeilen 11 bis 19 beschrieben ist. In diesen Entgegenhaltungen wird zwar ein Verfahren beschrieben, bei dem der Prozeß in einem Niedertemperaturplasma abläuft, es wird jedoch kein disperser kondensierter Kohlenstoff erzeugt, der als Reaktionsprudukteinem Niedertemperaturplasma ausgesetzt wird. Außerdem wird keine hybride Kohlenstoffphase verwendet, so daß die Entgegenhaltungen D5 und D6 als gattungsfremd zu betrachten sind.
- Die Entgegenhaltung D1 beschreibt die Ergebnisse einer Ramanspektroskopie. 2.a) Die Ramanspektroskopie gestattet nur quantitative Aussagen. Kristalline Phasenreinheiten, insbesondere des Diamants, lassen sich derzeit nur mittels x-Ray-Pattern (Röntgenphasenanalyse) bei Reflexionslinien (111), (129), (400) und (440) exakt ermitteln. Es ist somit richtig, daß die Diamantenpartikel gemäß der D1 eine hohe einheit haben. Eine Reinheit der kubischen Diamantphase von 99 % liegt jedoch bei den Produkten der D1 bei weitem nicht vor. Sogar hochreine Naturdiamanten weisen nicht mehr als 98 % Reinheit der kubischen Diamantphase auf und daher ist auch in der Entgegenhaltung D1 kein Hinweis auf eine Reinheit zu finden, die über 98 % fordert.
- Sowohl in der D1 als auch in den Entgegenhaltungen D2 und D3 ist kein Hinweis b) auf eine Reinheit zu entnehmen, wie sie in den Ansprüchen 5 bis 8 beschrieben wird.

3. Daher sind Ansprüche 1 - 12 neu und erfinderisch.

Patentansprüche:

檀色

- Verfahren zur dynamisch-chemischen Herstellung von diamantartigen
 Kohlenstoffstrukturen,
 - bei dem in einen geschlossenen Behälter eine hybride Kohlenstoffphase gegeben wird und
 - mit einem Energieträger zur chemischen Reaktion gebracht wird, um dispersen kondensierten Kohlenstoff als Reaktionsprodukt zu bilden,
- dadurch gekennzeichnet, daß das Reaktionsprodukt einem atomar wasserstoffgestützten Niedertemperatur-Plasma ausgesetzt wird und eine Phasenumwandlung von Kohlenstoffkombinationen in hochreine kubische Gitterstrukturen erzielt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich
 ein Kohlenstoffspendersystem eingebracht wird.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Kohlenstoffspendersystem flüssige oder gasförmige Kohlenwasserstoffverbindungen aufweist.

1.7-

2

- 4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Kohlenstoffspendersystem organische Kohlenstoffverbindungen aufweist.
- Diamantartige Kohlenstoffstruktur, dadurch gekennzeichnet, daß die
 Reinheit der kubischen Diamantphase bei 99 % vorzugsweise bei 100 % liegt.
 - 6. Diamantartige Kohlenstoffstruktur, dadurch gekennzeichnet, daß die Kristallitgrößen im Bereich zwischen 5 nm und 50 nm liegen.
- 7. Diamantartige Kohlenstoffstruktur, dadurch gekennzeichnet, daß die
 10 Cluster-Größenordnungen zwischen 50 nm und 20 µm liegen.
 - 8. Diamantartige Kohlenstoffstruktur, dadurch gekennzeichnet, daß die Partikeldurchmesser in Dispersion zwischen 40 nm und 500 nm liegen.
- 9. Verwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche, zur Oberflächenbearbeitung von harten Werkstoffen.
 - 10. Verwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 8, als elektrischer Isolator.
- Verwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, insbesondere
 nach einem der Ansprüche 1 bis 8, als Wärmeübertragungsmittel.

A. 1.

Liermann-Castell P01217WO

3

12. Verwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 8, als Zusatz zu einer Suspension, Dispersion, Emulsion, einem Spray, einer Paste, einem Fett oder einem Wachs.





PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

TT

(PCT Article 36 and Rule 70)

10/0/8634

P01217WO FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of Internet Preliminary Examination Report (Form PCT/IPE								
International application No.	International filing date		Priority date (day/month/year)					
PCT/DE00/01885	14 June 2000		18 June 1999 (18.06.99)					
International Patent Classification (IPC) or n C01B 31/06	International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C01B 31/06							
Applicant CARBO-TEC GESELLSCH	IAFT FÜR NANO-I	JND BIOTECH	NISCHE PRODUKTE MBH					
This international preliminary exar Authority and is transmitted to the approximately	nination report has been plicant according to Art	n prepared by this icle 36.	International Preliminary Examining					
2. This REPORT consists of a total of	4 sheets. i	ncluding this cover	sheet.					
been amended and are the ba	This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).							
These annexes consist of a total of3 sheets.								
3. This report contains indications relati	ing to the following item	s:	OCT 0 3 2002					
Basis of the report			2002					
II Priority								
III Non-establishment	of opinion with regard to	novelty, inventive	step and industrial applicability					
IV Lack of unity of inv	ention							
V Reasoned statement citations and explan	under Article 35(2) with ations supporting such st	regard to novelty, itatement	inventive step or industrial applicability;					
VI Certain documents of	eited							
VII Certain defects in th	e international application	n						
VIII Certain observations on the international application								
	·							
Date of submission of the demand Date of completion of this report								
18 December 2000 (18.12.00) 13 September 2001 (13.09.2001)								
Name and mailing address of the IPEA/EP	А	uthorized officer						
Facsimile No.		alanhona No	İ					



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

national application No.

PCT/DE00/01885

I. Basis of the report		
1. This report has been drawn under Article 14 are referred	n on the basis of (Replacement .	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation led" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):
	•	
	nal application as originally fil	
the description	n. pages1-28	as originally filed.
	pages	, filed with the demand.
	pages	. filed with the letter of
	pages	. filed with the letter of
the claims.	Nos.	, as originally filed
		. as amended under Article 19.
	· ·	, filed with the demand.
		filed with the letter of06 July 2001 (06.07.2001)
		. filed with the letter of
the drawings.	sheets/fig1/6-6/6	
		filed with the demand.
-		filed with the letter of
		. filed with the letter of
. The amendments have resul		
		
	pages	•
the claims.	Nos.	
the drawings.	sheets/fig	_
to go beyond the discl	established as if (some of) the a losure as filed, as indicated in	amendments had not been made, since they have been considered the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Additional observations, if n	ecessary:	
		i

INTERNATIONAL PRIMARY EXAMINATION REPORT

ernational application No.
PCT/DE 00/01885

YES

NO

1-12

	citations and explanations supporting such statement						
1.	Statement						
	Novelty (N)	Claims	1-12	YES			
		Claims		NO			
	Inventive step (IS)	Claims	1-12	YES			
		Claims		NO			

2. Citations and explanations

Industrial applicability (IA)

D1: YOSHIKAWA ET AL., APPLIED PHYSICS LETTERS,
Vol. 67, No. 5, 31 July 1995, pages 694-696

Claims

Claims

D2: XP 002 151 880

D3: XP 002 151 881

D4: DE 4 038 190

D5: XP 002 151 876

D6: XP 002 151 877.

- Prior art documents D5 and D6 describe processes for the chemical production of diamond-like carbon structures, whilst the present application describes a chemodynamic process where pressures of more than 10 GPa and temperatures in excess of 2000° may be attained for short periods. As a result, the process according to D5 and D6 yields a polycrystalline diamond film, whilst in the inventive process the result is essentially a nanometric diamond powder in monocrystalline form.
 - b) The polycrystalline diamond film resulting from a process as per D5 and D6 has a structure that is amorphous to X-rays, indicating that the cuboid lattice structures are not of high purity but distorted.

It is not possible to obtain nanometric diamond crystals of high purity, preferably in the form of a powder, by means of the process according to D5 and D6.

- The prior art documents D5 and D6 describe a CVD process such as that also described in the introductory part of the present application see page 1, lines 11-19. Although said prior art citations describe a process which takes place in a low-temperature plasma, said process did not yield a disperse condensed carbon exposed to a low-temperature plasma as a reaction product. Furthermore, since no hybrid carbon phase is used, D5 and D6 cannot be considered generically related.
- D1 describes the results obtained by Raman 2 a) spectroscopy. Raman spectroscopy affords only quantitative data. The accurate detection of crystalline phase purities, in particular of diamonds, is as yet possible only by means of X-ray patterning (X-ray phase analysis) using reflection lines (111, 129, 400 and 440). It is therefore to be expected that the diamond particles according to D1 should be of high purity. However, the products of D1 do not show a cuboid diamond phase purity of anywhere near 99%. Even high-purity natural diamonds do not show a cuboid diamond phase purity of greater than 98% and there is, therefore, no suggestion in D1 of how to obtain a purity in excess of 98%.

/ . . .

- b) No indication can be derived from D1, or from D2 and D3, of a purity such as that described in the present Claims 5 to 8.
- 3. Therefore Claims 1-12 are novel and involve an inventive step.

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner **US Department of Commerce** United States Patent and Trademark Office, PCT 2011 South Clark Place Room CP2/5C24 Arlington, VA 22202 **ETATS-UNIS D'AMERIQUE**

18 June 1999 (18.06.99)

Date of mailing (day/month/year) in its capacity as elected Office 13 March 2001 (13.03.01)

International application No. PCT/DE00/01885

International filing date (day/month/year)

14 June 2000 (14.06.00)

Applicant's or agent's file reference P01217WO Priority date (day/month/year)

Applicant SCHÖNEFELD, Christa et al

X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
18 December 2000 (18.12.00)
in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
The state of the Company of the Comp
The election X was was not
made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Christelle Croci

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38



From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

To:
CASTEL, Klaus
Patentanwaltskanziei LiermannCastel
Gutenbergstrasse 12
D-52349 Düren
ALLEMAGNE

D5. Jan. 2001

IMPORTANT NOTICE

Date of mailing (day/month/year)
28 December 2000 (28.12.00)

Applicant's or agent's file reference

Applicant's or agent's file reference
P01217WO

P01217WO International application No.

International filing date (day/month/year)
14 June 2000 (14.06.00)

Priority date (day/month/year)
18 June 1999 (18.06.99)

Patentanwait

Liermann-Castell

PCT/DE00/01886

SCHÖNEFELD, Christa et al

Notice is heraby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the International application
to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:
AU,KP,KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have walved the requirement for such a communication at this time:

AE,AL,AM,AP,AT,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,EA,EE,EP,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,OA,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,UA,U,LV,MD,WJ,ZA,ZW
The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 48.1(a-bis)).

 Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 28 December 2000 (28.12.00) under No. WO 00/78874

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent international Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

J. Zahra

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

WO 00/78674 PCT/DE00/01885



Continuation of Form PCT/IB/308

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

Date of mailing (day/month/year) 28 December 2000 (28.12.00)	IMPORTANT NOTICE
Applicant's or agent's file reference P01217WQ	International application No. PCT/DE00/01885

The applicant is hereby notified that, at the time of establishment of this Notice, the time limit under Rule 46.1 for making amendments under Article 19 has not yet expired and the international Bureau had received neither such amendments nor a declaration that the applicant does not wish to make amendments.

PATENT COOPERATION TREAL

	From the INTERNATIONAL BUREAU				
PCT	То:				
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422) Date of mailing (day/month/year) 05 February 2001 (05.02.01)	CASTEL, Klaus Patentanwaltskanzlei Liermann- Castel Gutenbergstrasse 12 D-52349 Düren ALLEMAGNE				
Applicant's or agent's file reference	IMPORTANT NOTIFICATION				
P01217WO	INFORTANT NOTIFICATION				
International application No. PCT/DE00/01885	International filing date (day/month/year) 14 June 2000 (14.06.00)				
1. The following indications appeared on record concerning:					
X the applicant the inventor	the agent the common representative				
Name and Address	State of Nationality State of Residence				
	Telephone No.				
	Facsimile No.				
	Teleprinter No.				
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that t	he following change has been recorded concerning:				
X the person X the name X the add	dress X the nationality X the residence				
Name and Address	State of Nationality State of Residence DE DE				
CARBO-TEC GESELLSCHAFT FÜR NANO- UND BIOTECHNISCHE PRODUKTE MBH Arnold-Sommerfeld-Ring 2	DE DE Telephone No.				
52499 Baesweiler Germany	Facsimile No.				
(Addional applicant for all designated States	i addinine ivo.				
except the United States of America):	Teleprinter No.				
3. Further observations, if necessary: Please note that SCHÖNEFELD, Christa has assigned and a second secon	gned her rights to the applicant indicated in				
4. A copy of this notification has been sent to:					
X the receiving Office	X the designated Offices concerned				
the International Searching Authority	the elected Offices concerned				
the International Preliminary Examining Authority	other:				
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Kari Huynh-Khuong				
Facsimile No : (/11-22) 7//0 1// 35	Tolonhone No. (41 22) 220 82 20				

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts						
P01217WO	VORGEHEN Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5					
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)				
PCT/DE 00/ 01885 14/06/2000 18/06/1999						
Anmelder						
SCHÖNEFELD, Christa						
Dieser internationale Recherchenbericht wurd	e von der Internationalen Recherchenbehörde	erstellt und wird dem Anmelder gemäß				
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	ernationalen Büro übermittelt.					
Dieser internationale Recherchenbericht umfa	ßt insgesamt 4 Blätter.					
	eils eine Kopie der in diesem Bericht genannte	n Unterlagen zum Stand der Technik bei.				
<u> </u>						
Grundlage des Berichts Hippiphiliph der Sprache int die inter-	motionala Dankaraka arif dar Oradia arif darif					
durchgeführt worden, in der sie einge	nationale Recherche auf der Grundlage der int ereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts	ernationalen Anmeldung in der Sprache s anderes angegeben ist.				
Die internationale Recherche Anmeldung (Regel 23.1 b)) o	e ist auf der Grundlage einer bei der Behörde e Jurchgeführt worden.	ingereichten Übersetzung der internationalen				
b. Hinsichtlich der in der internationaler	n Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/ode	r Amlnosäuresequenz ist die internationale				
l — —	equenzprotokolls durchgeführt worden, das dung in Schriflicher Form enthalten ist.					
	nalen Anmeldung in computerlesbarer Form ei	ngereicht worden ist.				
bei der Behörde nachträglich	in schriftlicher Form eingereicht worden ist.					
bei der Behörde nachträglich	in computerlesbarer Form eingereicht worden	ist.				
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung ir	träglich eingereichte schriftliche Sequenzprotol n Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgele	koll nicht über den Offenbarungsgehalt der gt.				
Die Erklärung, daß die in cor wurde vorgelegt.	nputerlesbarer Form erfaßten Informationen de	m schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,				
2. Bestimmte Ansprüche hab	en sich als nicht recherchierbar erwiesen (s	iehe Feld I).				
. =	der Erfindung (siehe Feld II).	,				
		·				
4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfind						
X wird der vom Anmelder einge						
wurde der Wortlaut von der E	sehorde wie folgt festgesetzt:					
	•					
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung	and the Mindle Annual Color					
wird der vom Anmelder einge wurde der Wortlaut nach Reg Anmelder kann der Behörde Recherchenberichts eine Ste	gel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassu innerhalb eines Monats nach dem Datum der A	ng von der Behörde festgesetzt. Der bsendung dieses internationalen				
	t mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen:	Abb. Nr1				
🗓 wie vom Anmelder vorgeschl		keine der Abb.				
weil der Anmelder selbst kein	ne Abbildung vorgeschlagen hat.					
weil diese Abbildung die Erfir	ndung besser kennzeichnet.					

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 C01B31/06 C01B31/02

C01B31/02

C09K3/14

C09K5/14

H01B3/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

C01B C09K IPK 7

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, EPO-Internal, CHEM ABS Data

Ç.	ALS V	NESEN	NTLICH	ANGE	SE	HEN	ΕU	NTE	ERLAG	EΝ

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	YOSHIKAWA M ET AL: "RAMAN SCATTERING FROM NANOMETER-SIZED DIAMOND" APPLIED PHYSICS LETTERS,US,AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, Bd. 67, Nr. 5, 31. Juli 1995 (1995-07-31), Seiten 694-696, XP000520546 ISSN: 0003-6951 das ganze Dokument	5-9,12
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 199301 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class M11, AN 1993-005087 XP002151880 & JP 04 333599 A (TOKYO DIAMOND KOGU SEISAKUSHO), 20. November 1992 (1992-11-20) Zusammenfassung	5-7,12

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

2. November 2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

15/11/2000

Bevollmächtigter Bediensteter

Rigondaud, B



	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	I Debr. Ame.
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 4 767 608 A (MATSUMOTO SEIICHIRO ET AL) 30. August 1988 (1988-08-30) Ansprüche 1-14 Beispiel 4	6
A		1
Α	WO 90 05701 A (GOOD ANDREW CAREY) 31. Mai 1990 (1990-05-31) Seite 7, Zeile 21 - Zeile 30	1,7,9
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 199315 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E36, AN 1993-121190 XP002151881 & JP 05 058784 A (TOYOTA CENT RES & DEV LAB), 9. März 1993 (1993-03-09) Zusammenfassung	6,7
A	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; MARUYAMA, KATSUHISA ET AL: "Synthesis of cubic diamond by hydrogen plasma jet" retrieved from STN Database accession no. 116:111974 CA XP002151879 Zusammenfassung & KOGAI SHIGEN KENKYUSHO IHO (1991), 21(1), 23-30 , 1991,	1,5
A	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Effect of ion flux on the growth of diamond-like films in a low-temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 128:161101 CA XP002151876 Zusammenfassung & ZH. FIZ. KHIM. (1997), 71(6), 1137-1139	1
	'1997, 	

1

		CI/DE U	DE 00/01885				
C.(Fortsetz	C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN						
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommender	n Teile	Betr. Anspruch Nr.				
Α	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Growth and properties of diamond-like films deposited from cyclohexane-argon mixtures in low-temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 126:134622 CA XP002151877 Zusammenfassung & IZV. AKAD. NAUK, SER. KHIM. (1996), (10), 2419-2421, 1996,		1				
	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Diamond-like films deposition from the mixtures of cyclohexane with argon in low temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 126:11820 CA XP002151878 Zusammenfassung & DOKL. AKAD. NAUK (1996), 349(2), 212-214		1				
	BUERKI P R ET AL: "CO2-LASER-INDUCED VAPOR-PHASE SYNTHESIS OF HN-DIAMOND NANOPARTICLESAT 0.6 - 2 BAR" NANOSTRUCTURED MATERIALS,US,PERGAMON PRESS, TARRYWOOD, NY, Bd. 4, Nr. 5, 1. September 1994 (1994-09-01), Seiten 577-582, XP000460804 ISSN: 0965-9773 Absatz '05.2!		6,7,12				
	DE 40 38 190 A (GENERAL ELECTRIC) 13. Juni 1991 (1991-06-13) Anspruch 24		5				
	DATABASE WPI Section Ch, Week 199425 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E36, AN 1994-208076 XP002151882 & TW 224 076 A (NAT SCI COMMITTEE), 21. Mai 1994 (1994-05-21) Zusammenfassung		·				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nal Application No PCT/DE 00/01885

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C01B31/06 C01B

C01B31/02

C09K3/14

C09K5/14

H01B3/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C01B C09K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, EPO-Internal, CHEM ABS Data

C. DOCUM	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Refevant to claim No.
X	YOSHIKAWA M ET AL: "RAMAN SCATTERING FROM NANOMETER-SIZED DIAMOND" APPLIED PHYSICS LETTERS,US,AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, vol. 67, no. 5, 31 July 1995 (1995-07-31), pages 694-696, XP000520546 ISSN: 0003-6951 the whole document	5-9,12
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 199301 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class M11, AN 1993-005087 XP002151880 & JP 04 333599 A (TOKYO DIAMOND KOGU SEISAKUSHO), 20 November 1992 (1992-11-20) abstract	5-7,12

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents :	"T" later document published after the international fil
A document defining the general state of the art which is not	or priority date and not in conflict with the application of the cited to understand the principle or theory, under

- considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international
- filing date
- document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but
- later than the priority date claimed

- filing date ication but invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

2 November 2000

Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

15/11/2000

Authorized officer

Rigondaud, B

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern all Application No PCT/DE 00/01885

(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
ategory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
(US 4 767 608 A (MATSUMOTO SEIICHIRO ET AL) 30 August 1988 (1988-08-30) claims 1-14	6		
1	example 4	1		
1	WO 90 05701 A (GOOD ANDREW CAREY) 31 May 1990 (1990-05-31) page 7, line 21 - line 30	1,7,9		
	DATABASE WPI Section Ch, Week 199315 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E36, AN 1993-121190 XP002151881 & JP 05 058784 A (TOYOTA CENT RES & DEV LAB), 9 March 1993 (1993-03-09) abstract	6,7		
A	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; MARUYAMA, KATSUHISA ET AL: "Synthesis of cubic diamond by hydrogen plasma jet" retrieved from STN Database accession no. 116:111974 CA XP002151879 abstract & KOGAI SHIGEN KENKYUSHO IHO (1991), 21(1), 23-30, 1991,	1,5		
A	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Effect of ion flux on the growth of diamond-like films in a low-temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 128:161101 CA XP002151876	1		
,	abstract & ZH. FIZ. KHIM. (1997), 71(6), 1137-1139 '1997,/			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interr nal Application No
PCT/DE 00/01885

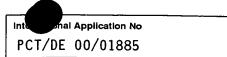
Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		0/01885
ात्वारा का document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Growth and properties of diamond-like films deposited from cyclohexane-argon mixtures in low-temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 126:134622 CA XP002151877 abstract & IZV. AKAD. NAUK, SER. KHIM. (1996), (10), 2419-2421, 1996,		1
DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Diamond-like films deposition from the mixtures of cyclohexane with argon in low temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 126:11820 CA XP002151878 abstract & DOKL. AKAD. NAUK (1996), 349(2), 212-214		1
1996, BUERKI P R ET AL: "CO2-LASER-INDUCED		6,7,12
VAPOR-PHASE SYNTHESIS OF HN-DIAMOND NANOPARTICLESAT 0.6 - 2 BAR" NANOSTRUCTURED MATERIALS,US,PERGAMON PRESS, TARRYWOOD, NY, vol. 4, no. 5, 1 September 1994 (1994-09-01), pages 577-582, XP000460804 ISSN: 0965-9773 paragraph '05.2!		
DE 40 38 190 A (GENERAL ELECTRIC) 13 June 1991 (1991-06-13) claim 24		5
DATABASE WPI Section Ch, Week 199425 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E36, AN 1994-208076 XP002151882 & TW 224 076 A (NAT SCI COMMITTEE), 21 May 1994 (1994-05-21)		
	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Growth and properties of diamond—like films deposited from cyclohexane—argon mixtures in low—temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 126:134622 CA XP002151877 abstract & IZV. AKAD. NAUK, SER. KHIM. (1996), (10), 2419—2421, 1996, DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Diamond—like films deposition from the mixtures of cyclohexane with argon in low temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 126:11820 CA XP002151878 abstract & DOKL. AKAD. NAUK (1996), 349(2), 212—214 '1996, BUERKI P R ET AL: "CO2—LASER—INDUCED VAPOR—PHASE SYNTHESIS OF HN—DIAMOND NANOPARTICLESAT 0.6—2 BAR" NANOSTRUCTURED MATERIALS, US, PERGAMON PRESS, TARRYWOOD, NY, vol. 4, no. 5, 1 September 1994 (1994—09—01), pages 577—582, XP000460804 ISSN: 0965—9773 paragraph '05.2! DE 40 38 190 A (GENERAL ELECTRIC) 13 June 1991 (1991—06—13) claim 24 DATABASE WPI Section Ch, Week 199425 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E36, AN 1994—208076 XP002151882	Claston of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Growth and properties of diamond-like films deposited from cyclohexane-argon mixtures in low-temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 126:134622 CA XPO02151877 abstract å IZV. AKAD. NAUK, SER. KHIM. (1996), (10), 2419-2421, 1996, DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Diamond-like films deposition from the mixtures of cyclohexane with argon in low temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 126:11820 CA XPO02151878 abstract å DOKL. AKAD. NAUK (1996), 349(2), 212-214 '1996, BUERKI P R ET AL: "CO2-LASER-INDUCED VAPOR-PHASE SYNTHESIS OF HN-DIAMOND NANOPARTICLESAT 0.6 - 2 BAR" NANOSTRUCTURED MATERIALS, US, PERGAMON PRESS, TARRYWOOD, NY, vol. 4, no. 5, 1 September 1994 (1994-09-01), pages 577-582, XPO00460804 ISSN: 0965-9773 paragraph '05.2! DE 40 38 190 A (GENERAL ELECTRIC) 13 June 1991 (1991-06-13) claim 24 DATABASE WPI Section Ch, Week 199425 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E36, AN 1994-208076 XPO02151882

IN ANATIONAL SEARCH REPURT

. Jimation on patent family members

intern val Application No
PCT/DE 00/01885

	tent document in search repor	t	Publication date		atent family nember(s)	Publication date
JP	4333599	Α	20-11-1992	NONE		
US	4767608	Α	30-08-1988	JP JP	1716847 C 3046436 B	14-12-1992 16-07-1991
				JP	63107898 A	12-05-1988
WO	9005701	Α	31-05-1990	NONE		
JP	5058784	Α	09-03-1993	NONE		
DE	4038190	Α	13-06-1991	AU AU	634601 B 6672590 A	25-02-1993 13-06-1991
				BE	1004218 A	13-10-1992
				BR	9006262 A	24-09-1991
				CA CN	2030049 A 1052340 A	12-06-1991 19-06-1991
				FR	2655639 A	14-06-1991
				GB	2239011 A,B	19-06-1991
				JP	1945094 C	23-06-1995
				JP	4108532 A	09-04-1992
	•			JP	6071549 B	14-09-1994
				KR	9307855 B	20-08-1993
				NL	9002600 A	01-07-1991
				SE	9003939 A	12-06-1991
				US	5419276 A	30-05-1995
				US	5540904 A	30-07-1996
				US	5310447 A	10-05-1994
				ZA	9009526 A	27-11-1991
				CA	2042267 A	12-12-1991
TW	224076	Α		NONE		



-				
Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
JP 4333599	Α	20-11-1992	NONE	
US 4767608	Α	30-08-1988	JP 1716847 C JP 3046436 B JP 63107898 A	14-12-1992 16-07-1991 12-05-1988
WO 9005701	Α	31-05-1990	NONE	
JP 5058784	Α	09-03-1993	NONE	
DE 4038190	A .	13-06-1991	AU 634601 B AU 6672590 A BE 1004218 A BR 9006262 A CA 2030049 A CN 1052340 A FR 2655639 A GB 2239011 A,B JP 1945094 C JP 4108532 A JP 6071549 B KR 9307855 B NL 9002600 A SE 9003939 A US 5419276 A US 5540904 A US 5310447 A ZA 9009526 A CA 2042267 A	25-02-1993 13-06-1991 13-10-1992 24-09-1991 12-06-1991 19-06-1991 19-06-1991 23-06-1995 09-04-1992 14-09-1994 20-08-1993 01-07-1991 12-06-1991 30-05-1995 30-07-1996 10-05-1994 27-11-1991 12-12-1991
TW 224076	 А		 NONE	

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record



BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.